

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0401U001245

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-05-2001

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Селіверстова Світлана Ростиславівна

2. Syeliverstova Svitlana Rostyslavivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.27.06

Назва наукової спеціальності: Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 06-04-2001

Спеціальність за освітою: 20.02

Місце роботи здобувача: Херсонський державний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05480298

Місцезнаходження: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 67.052.03

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Херсонський державний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05480298

Місцезнаходження: 73008, м.Херсон, Бериславське шосе, 24

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Тема дисертації:

1. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі GaAs
2. Influence of growing technology on micromechanical properties of epitaxial structures based on GaAs 5742

Реферат:

1. Гомо- та гетероструктури на основі GaAs, отримані ГФЕ та РФЕ. Визначення зв'язку між мікромеханічними властивостями епітаксійних структур та умовами їх отримання. Дослідження проводились з використанням методів інденування та склерометрії за допомогою піраміди Віккерса; мікроскопії, ФЛ, ефекту Холлу. Встановлено, що в GaAs, легованому Si, мікротвердість змінюється зі зміною ступеня компенсації. За допомогою розробленого метода дослідження деформованих областей травлення парами йоду, встановлено, що в Ge-GaAs напрямок деформації змінюється при досягненні гетеромежі. Сферою використання є виробництво напівпровідникових приладів
2. Homo- and heteroepitaxial structures based on GaAs, grown by liquid phase and vapor phase epitaxy. Determination of the connection between micromechanic properties of epitaxial structures and conditions of their obtaining. The investigations was carried out by the methods of dimpling and scratching using Vickers pyramid, microscopy, Hall effect. It was determined that microhardness of GaAs doped by Si changes at the change of compensation level. The method of investigation of deformed areas by etching in iodine vapor was proposed and

developed. Using this method, it was revealed that direction of deformation distribution in Ge-GaAs changes on reaching a heteroboundary. The field of application is a production of semiconductor devices.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Марончук І.Є.

2. Марончук І.Є.

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Матвеева Л.О.

2. Матвеева Л.О.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шарко О.В.

2. Шарко О.В.

Кваліфікація: д.т.н., 05.11.13

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Марончук І.Є

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Марончук І.Є

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.